

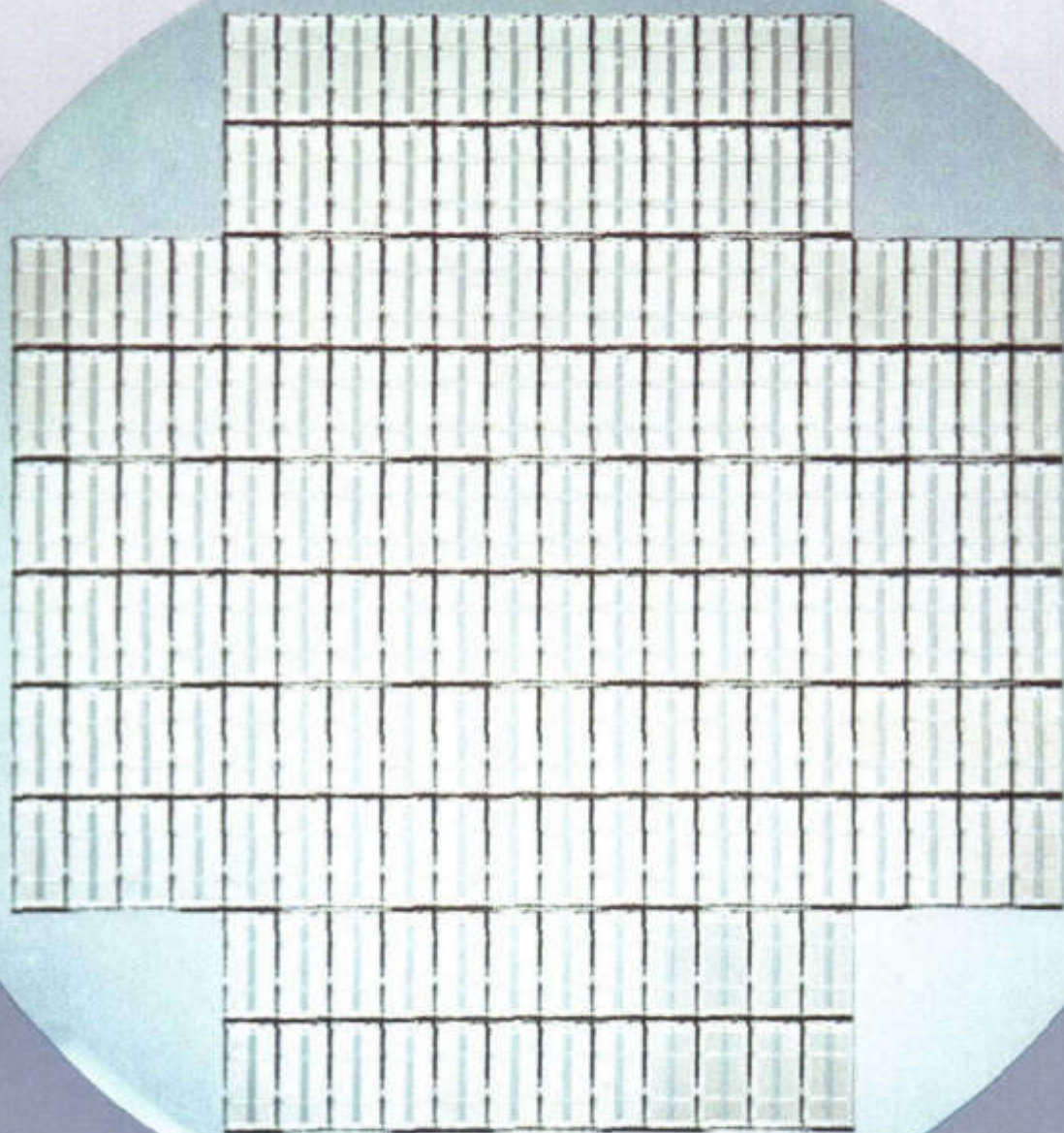


ZEISS

Mikro-
elektronische
Bauelemente

UL 6516 DG

Statischer Speicher



UL 6516 DG

Statischer Schreib-/Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (SRAM)

Kurzcharakteristik

- Speicherkapazität:
16 384 Bit
- Organisation:
2 k × 8 Bit
- Zugriffszeit:
150 ns (für Grundtyp UL 6516 DG 15,
für Anfalltyp U 6516 DG 15)
250 ns (für UL 6516 DG 25)
- Betriebsspannung:
+ 5 V
- geringer Ruhestrom
max. 10 µA (UL 6516 DG 15,
UL 6516 DG 25)
max. 100 µA (U 6516 DG 15)
- Gemeinsame (bidirektionale)
Datenein-/ausgänge
- 2 Enable-Signale
- Adreßlatch – damit nur getakteter
Betrieb möglich
- TTL-Kompatibilität für alle Anschlüsse
- Datenerhalt bis zu einer Betriebsspan-
nung $U_{CC} = 2$ V (Schlafzustand)
- 24poliges DIL-Plastgehäuse
- Pinkompatibel zum EPROM U 2716 C
- Vergleichstyp:
HM 6516-5 (UL 6516 DG 25)
HM 6516-8 (UL 6516 DG 15)

Technische Daten

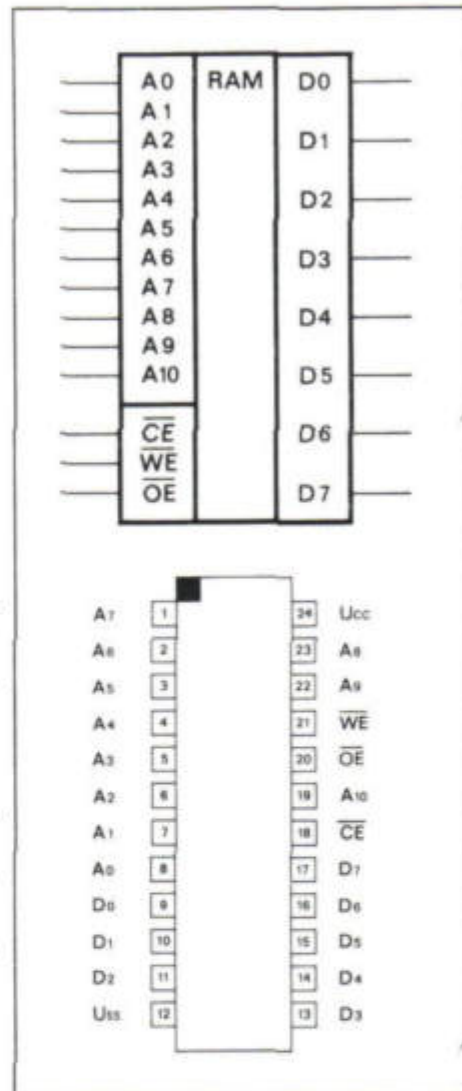
Grenzwerte

Alle Spannungen sind auf $U_{SS} = 0$ V bezogen

Kennwerte	Kurz- zeichen	min	max	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	-0,3	7	V
Spannung an allen Eingängen	U_i	-0,3	$U_{CC} + 0,3$	V
Verlustleistung	P_{tot}		1	W
Lagertemperatur	θ_a	-55	125	°C

Betriebsbedingungen

Kennwerte	Kurz- zeichen	min	max	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	4,75	5,25	V
Eingangs-Low-Spannung	U_{iL}	-0,3	0,8	V
Eingangs-High-Spannung	U_{iH}	2,0	$U_{CC} + 0,3$	V
Schlafspannung	U_{CCS}	2,0		V
Umgebungstemperatur	θ_a	-25	85	°C



Anschlußbelegung und Schaltzeichen

Markierung kennzeichnet Seite mit Pin 1

- A0 bis A 10 Adreßeingänge
- D0 bis D 7 Datenein-/ausgänge
- $\overline{CE}$ Chipauswahl
- $\overline{WE}$ Lese-/Schreibsteuerung
- $\overline{OE}$ Datenausgangsaktivierung
- U_{CC} Betriebsspannung
- U_{SS} Masse



VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombinales
VEB Carl Zeiss JENA
Carl-Zeiss-Str.1
Jena
DDR-6900